PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-152036

(43) Date of publication of application: 23.05.2003

(51)Int.Cl.

H01L 21/66

G01R 1/067

G01R 1/073

G01R 31/26

G01R 31/28

(21)Application number : 2001-346284

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

12.11.2001

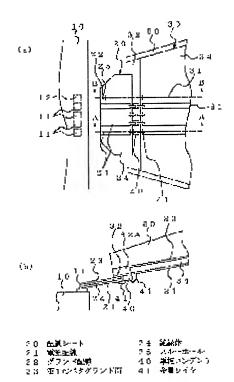
(72)Inventor: MATSUNAGA KOJI

(54) MULTIPLE-PIN POWER SUPPLY PROBE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multiple-pin power supply prove in which the inductance component of the point of the probe is reduced and power can be supplied to a high-frequency semiconductor device in which adjacent ground electrode is not disposed at a plurality of power source electrodes.

SOLUTION: The multiple-pin power supply prove comprises a first solid ground surface 23 disposed on the opposite surface of a power wiring 21 brought into contact with the electrode of the device 10 to be inspected and a ground wiring 22 via an insulator 24 in such a manner that the wiring 22 is electrically connected to the first solid ground surface 23 via a through hole 25. The electrode 12 is conducted to the



wiring 22 so that the first solid ground surface 23 is set to the same potential as the ground of the device 10 and the inductance component of the wiring 21 is reduced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-152036 (P2003-152036A)

Ĭ デーマコート*(参考)				
G003				
G011				
G132				
M106				
K				
(全 8 頁)				

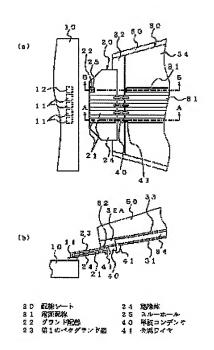
日本電気株				
	•			
最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】 多ピン電源供給プローブ

(57)【要約】

【課題】プローブの先端部分のインダクタンス成分を低 減し、かつ複数ある電源電極に個々に隣接したグランド 電極を配置していない半導体高周波デバイスへの電源供 給を行うことが可能な多ピン電源供給プローブを提供す S.

【解決手段】接続査デバイス10の電極に接触する電源 配線21、グランド配線22の反対面に絶縁体24を介 して配置する第1のベタグランド面23を有し、スルー ホール25によりグランド配線22と第1のベタグラン ド面23を電気的に接続する。グランド電極12とグラ ンド配線22が導通することにより、第1のベタグラン 下面23が被検査デバイス10のグランドと同電位とな り、電源配線21のインダクタンス成分を低減する。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電源電極とグランド電極が同一平面上 で、かつ一列に存在して配置してある半導体デバイスへ 電源供給するプローブにおいて、

1

被検査デバイスの電源電極に接触し直線状で互いに平行 配置する電源配線と、前記被検査デバイスのグランド電 極に接触し前記電源配線と同一面に配置するグランド配 線と、前記電源配線と前記グランド配線を配置する面と 反対面に絶縁体を介して全体的に形成された第1のグラ ンド面と、前記グランド配線と前記第1のグランド面と 10 る多ピン電源供給プローブ。 を電気的に接続するスルーホールとを有する配線シート

前記第1のグランド面の前記被検査デバイスの電極と接 触する先繼部分と反対方向であって前記第1のグランド 面と電気的に接続するグランドラインと、前記グランド ラインと同一面にあって直線状で互いに平行配置する伝 送路と、前記任送路を配置する面と反対面に絶縁体を介 して配置しかつ前記グランドラインと絶縁体の側面を介 して電気的に導通する全体的に形成された第2のグラン ド面とを有する伝送路基板と、

前記グランドラインと電気的に接続しかつ前記配線シー トと前記伝送路の間であって前記電源配線の延長線上の 位置に配置する単板コンデンサと、

前記電源配線と前記単板コンデンサおよび前記伝送路と 前記単板コンデンサをそれぞれ接続する金属ワイヤと、 前記第2のグランド面と接続し前記伝送路基板の上側に 配置する支持ブロックと、

を具備して構成されることを特徴とする多ピン電源供給 プローブ。

において、前記配線シートに配置する前記電源配線と前 記グランド配線の前記数検査デバイスの電極と接触する 先端部分が突出し、突出する前記電源配線と前記グラン ド配線の上側に前記絶縁体と前記第1のグランド面を形 成する形状の配線シートを有することを特徴とする多ビ ン電源供給プローブ。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載の多ピン電 源供給プローブにおいて、前記電源配線と前記グランド 配線の前記被検査デバイスの電極と接触する先端部分に 金鷹突起を設けることを特徴とする多ピン電源供給プロ 40 【0001】

【請求項4】 請求項1または請求項2記載の多ピン電 源供給プローブにおいて、前記数検査デバイスに隣接し た同一電源電圧の電源電極がある場合。同一電源電圧の 電源電極に接触する前記電源配線と接続する前記単板コ ンデンサを1つの単板コンデンサで形成することを特徴 とする多ピン電源供給プローブ。

【請求項5】 請求項1または請求項2記載の多ピン電 源供給プローブにおいて、前記紋検査デバイスの隣接し た同一電源電圧の電源電極がある場合。同一電源電圧の 50 に使用する測定環境は、主に被検査デバイスの電極に接

電源電極に接触する前記電源配線の被検査デバイスと接 触する先端部分を除き電源配線間の隙間を金属配線で埋 めた電源配線を形成することを特徴とする多ピン電源供 給プローブ。

【請求項6】 請求項1から請求項5のいずれかに記載 の多ピン電源供給プローブにおいて、前記金属ワイヤに かえて前記金属ワイヤより断面積の大きい金属リボンで 前記電源配線と前記単板コンデンサおよび前記任送路と 前記単板コンデンサをそれぞれ接続することを特徴とす

【請求項7】 電源電極とグランド電極が同一平面上に なく、かつ電源電極と反対面にグランド電極が配置して ある半導体デバイスへ電源供給するプローブにおいて、 被検査デバイスの電源電極に接触し直線状で互いに平行 配置する電源配線と、前記電源配線を配置する面と反対 面に絶縁体を介して全体的に形成された第1のグランド 面を有する配線シートと、

前記第1のグランド面の前記紋検査デバイスの電極と接 触する先端部分と反対方向であって前記第1のグランド 20 面と電気的に接続するグランドラインと、前記グランド ラインと同一面にあって直線状で互いに平行配置する伝 送路と、前記伝送路を配置する面と反対面に絶縁体を介 して配置しかつ前記グランドラインと絶縁体の側面を介 して電気的に導通する全体的に形成された第2のグラン ド面とを有する伝送路基板と、

前記グランドラインと電気的に接続しかつ前記配線シー トと前記伝送路の間で

あって前記電源配線の延長線上の位置に配置する単板コ ンデンサと、前記電源配線と前記単板コンデンサおよび 【請求項2】 請求項1記載の多ピン電源供給プローブ 30 前記任送路と前記単板コンデンサをそれぞれ接続する金 属ウイヤと、

> 前記グランドラインと電気的に接続し前記紋検査デバイ スのグランド電極と接続する金属ステージに接触するグ ランドブロックと、

> 前記第2のグランド面と接続し前記任送路基板の上側に 配置する支持ブロックと、

> を具備して構成されることを特徴とする多ピン電源供給 プローブ。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は多ピン電源供給プロ ープに係わり、特に、ウェハ状態、またはベアチップ状 艦の半導体高層波デバイスへの電源供給に使用するプロ ープに関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般的に半導体デバイス、特に高い周波 数で使用するデバイスは、材料が高価であるため製品に 組み込む前のウェハ状態。またはウェハから切り出した ベアチップ状態で電気検査が実施される。この電気検査

12/13/2006

触するプロープと、プローブを介して得られる入出力信 号を取り込んでその信号を必要な情報に処理する計測器 と、プローブと計測器を接続する高周波対応ケーブルで 模成される。

3

【①①①3】彼検査デバイスの電極に接触するプローブ には2種類のプローブがあり、一方は被検査デバイスに 電源を供給する電源供給用のプローブ、もう一方は高い 国波数の入出力信号を扱う高周波信号用のブローブであ

行うプローブの従来例を説明するための図であり、特別 平8-226934号公報に関示されている。

【①①05】図9において、彼検査デバイスの電源用バ ッドちとグランド用パッド6に、それぞれ電源用探針3 a.グランド用探針3bを接触させており、電源用探針 3aとグランド用綵針3bの間にコンデンサ7を挿入し ている。コンデンサイを被検査デバイスの電極に近い位 置で挿入するととにより、プローブの先端部分のインダ クタンス成分を減少させている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し た従来の構造では、プローブの先端部分のインダクタン ス成分を減少させるためには独検査デバイスの個々の電 源電極に隣接して面積の大小を聞わずグランド電極が必 要となり、電極数が増えるために被検査デバイスの面積 が大きくなってしまう。これは、材料が高価な半導体高 周波デバイスにおいて、デバイスを搭載する製品コスト の増加につながる。

【0007】また、探針の間にコンデンサを挿入するこ とからコンデンサ自身の寸法制限により、狭ビッチ(例 30 えば200μm以下)の電極配置を持つ被検査デバイス では電源電極にプローブが接触できず、従来のプローブ で電源供給を行うことは不可能である。

【①①08】したがって本発明の目的は、プローブの先 端部分のインダクタンス成分を低減し. かつ複数ある電 源電極に個々に隣接したグランド電極が配置していない。 半導体高周波デバイスへの電源供給を行うプローブを提 供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、電源電 40 極とグランド電極が同一平面上で、かつ一列に存在して 配置してある半導体デバイスへ電源供給するプローブに おいて、彼検査デバイスの電源電極に接触し直線状で互 いに平行配置する電源配線と、前記接換査デバイスのグ ランド電極に接触し前記電源配線と同一面に配置するグ ランド配線と、前記電源配線と前記グランド配線を配置 する面と反対面に絶縁体を介して全体的に形成された第 1のグランド面と、前記グランド配線と前記第1のグラ ンド面とを電気的に接続するスルーホールとを有する配

スの電極と接触する先端部分と反対方向であって前記第 1のグランド面と電気的に接続するグランドラインと、 前記グランドラインと同一面にあって直線状で互いに平 行配置する伝送路と、前記伝送路を配置する面と反対面 に絶縁体を介して配置しかつ前記グランドラインと絶縁 体の側面を介して電気的に製運する全体的に形成された 第2のグランド面とを有する伝送路基板と、前記グラン ドラインと電気的に接続しかつ前記配線シートと前記伝 送路の間であって前記電源配線の延長線上の位置に配置 【0004】図9に示すプローブは、前者の電源供給を 10 する単板コンデンサと、前記電源配線と前記単板コンデ ンサおよび前記任送路と前記単板コンデンサをそれぞれ 接続する金属ワイヤと、前記第2のグランド面と接続し 前記任送路基板の上側に配置する支持ブロックと、を具 借してで構成される多ピン電源供給プローブにある。

【①①10】ここで、全体的に形成された第1のグラン ド面とは、複数の電源配線にそれぞれ対応してバターン ニングされたグランド配線層ではなく、これらの複数の 電源配線と対向して一面に連続的に形成されたグランド 層のことを意味し、以後、第1のベタグランド面、と称

【()()11]同様に、全体的に形成された第2のグラン 下面とは、複数の伝送器にそれぞれ対応してパターンニ ングされたグランド配線ではなく、これらの複数の伝送 路と対向して一面に連続的に形成されたグランド層のこ とを意味し、以後、第2のベタグランド面、と称す。 【①①12】上記した多ピン電源供給プローブにおい で、前記配線シートに配置する前記電源配線と前記グラ

ンド配線の前記被検査デバイスの電極と接触する先端部 分が突出し、突出する前記電源配線と前記グランド配線 の上側に前記絶縁体と前記第1のベタグランド面を形成 する形状の配線シートを有することができる。

【0013】あるいは、上記した多ピン電源供給プロー ブー前記電源配線と前記グランド配線の前記被検査デバ イスの電極と接触する先端部分に金属突起を設けること ができる。

【0014】さらに、上記した多ピン電源供給プローブ において、前記核検査デバイスに隣接した同一電源電圧 の電源電極がある場合、同一電源電圧の電源電極に接触 する前記電源配線と接続する前記単級コンデンサを1つ の単板コンデンサで形成することができる。

【10015】また、多ピン電源供給プローブにおいて、 前記被検査デバイスの隣接した同一電源電圧の電源電極 がある場合、同一電源電圧の電源電極に接触する前記電 源配線の被検査デバイスと接触する先端部分を除き電源 配線間の隙間を金属配線で埋めた電源配線を形成するこ とができる。

【0016】さらに、上記した多ピン電源供給プローブ において、前記金属ワイヤより断面積の大きい金属リボ ンで前記電源配線と前記単板コンデンサおよび前記伝送 **線シートと、前記第1のグランド面の前記紋検査デバイ 50 踏と前記単板コンデンサをそれぞれ接続することができ**

(4)

特関2003-152036

【()()17]本発明の他の特徴は、電源電極とグランド 電極が同一平面上になく、かつ電源電極と反対面にグラ ンド電極が配置してある半導体デバイスへ電源供給する プローブにおいて、彼検査デバイスの電源電極に接触し 直線状で互いに平行配置する電源配線と、前記電源配線 を配置する面と反対面に絶縁体を介して形成された第1 のベタグランド面を有する配線シートと、前記第1のベ タグランド面の前記数検査デバイスの電極と接触する先 **端部分と反対方向であって前記第1のベタグランド面と 10** 電気的に接続するグランドラインと、前記グランドライ ンと同一面にあって直線状で互いに平行配置する任送器 と、前記伝送路を配置する面と反対面に絶縁体を介して 配置しかつ前記グランドラインと絶縁体の側面を介して 電気的に導通する第2のベタグランド面とを有する伝送 「鎔基級と、前記グランドラインと電気的に接続しかつ前 記配線シートと前記伝送路の間であって前記電源配線の 延長線上の位置に配置する単板コンデンサと、前記電源 配線と前記単板コンデンサおよび前記任送路と前記単板 コンデンサをそれぞれ接続する金属ワイヤと、前記グラ ンドラインと電気的に接続し前記数検査デバイスのグラ ンド電極と接続する金属ステージに接触するグランドブ ロックと、前記第2のベタグランド面と接続し前記伝送 路墓板の上側に配置する支持ブロックと、を具備してで 構成される多ピン電源供給プローブにある。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施 の形態を説明する。

【①①19】図1、図2は、本発明による多ピン電源供 給プローブの第1の実施の形態による構成を説明するも のである。図1(a)は、接検査デバイスに接触する前 の状態を下から見た下面図である。図1(り)は、彼検 査デバイスに接触しているときの側面図である。図2

(a)は、図1(a)に示す第1の実施の形態のA-A 部の断面図であり、図2(b)は図1(a)に示す第1 の実施の形態のB-B部の断面図である。

【0020】図1(a)において、複検査デバイス10 は5つの電極が一列に並んでおり、そのうち4つが電源 電極11で、1つがグランド電極12であり、電極のあ る面と反対面にはグランド電極は存在しない。

【0021】4つの電源電極11は、同一種類の電源電 圧であっても異なる種類の電源電圧であってもよい。ま た。電源電極11を4つ。グランド電極12を1つとし て図示しているが、電源電便11が1つ以上ありグラン 下電極12が1つ以上あればよく、電源電極11に個々 に隣接するグランド電極12を設けなくとも被検査デバ イス10への電源供給は可能である。

【①022】複検査デバイスの複数の電極には、配線シ ート20の下側である数検査デバイス側に配置する電源 配線21とグランド配線22が接触する。電源配線21 50 けまたは導電性接着剤で電気的に導通するように接続し

とグランド配線22は、電源電極11とグランド電極1 2の位置に合わせて配置する。

【10023】電源配線21の形状は、直線状をしており 互いに平行配置してある。その配線幅は電源電極11よ り小さい寸法で形成してある。

【① 0 2 4 】グランド配線22にはスルーホール25が 設けてあり、その配線幅も電源配線21と同様でグラン ド電極12より小さい寸法で形成する。

【0025】図1(り)に示すように、配線シートには グランド配線22の反対面に絶縁体24を介して第1の ベタグランド面23が設けてあり、スルーホール25を 介してグランド配線22と第1のベタグランド面23を 電気的に接続している。との第1のベタグランド面23 は、配線シートにある絶縁体24の全面に形成してあ

【0026】とのように、グランド電極12と同電位と なる第1のベタグランド面23が電源配線21の上側に あることより、電源配線21とグランド配線22の間に コンデンサを挿入することなく電源配線21の先端部分 20 のインダクタンス成分を低減できる。これにより、電源 配線21どうしの間隔および電源配線21とグランド配 線22の間隔を小さくでき、狭ビッチ(例えば200m m以下)の電極配置を持つ核検査デバイスへの電源供給 が可能となる。

【10027】図1 (a) において、伝送路基板30の彼 検査デバイス10側には、伝送路31とグランドライン 32が配置してある。

【0028】任送路31は、電源配線21とグランド配 線22に対してそれぞれ一対一対応で配置してあり、彼 検査デバイスの電極数と同じ数だけ必要となる。伝送路 31の形状は、直線状をしており互いに平行となるよう 配置してある。

【10029】グランドライン32は、伝送路基板30の 伝送路31が配置してある面と同一面にあり、グランド ライン32と配線シート20の第1のベタグランド面2 3とは被検査デバイス10側と反対側で接続している。 この接続は、はんだ付けまたは導電性接着剤で行い、電 気的に導通している。これにより、グランドライン32 は被検査デバイス10のグランド電便12と同電位にな 40 る。

【0030】図1(b)に示すように、伝送路墓板30 には、伝送路31とグランドライン32の反対面に絶縁 体34を介して第2のベタグランド面33が設けてあ り、伝送路基板30の被検査デバイス10側の先端部分 の側面にグランドライン32と連続的に形成された導電 層32Aを介して第2のベタグランド面33とグランド ライン32が接続している。

【①①31】配線シート20と伝送路31の間にあるグ ランドライン32には、単板コンデンサ40がはんだ付 てある。単板コンデンサ40は、配線シート20に個々 に配置した電源配線21の延長した直線状に位置すると とろに配置してある。単数コンデンサ40によりさらに 大きな容置を付加することができる。

7

【0032】電源配線21と伝送路31は、単板コンデ ンサ40に金属ワイヤ41でそれぞれ電気的に接続して ある。

【0033】また、伝送路墓板30の第2のベタグラン 下面33が配置してある面に支持ブロック50が配置し てある。これにより、伝送路基板30の強度を補強し伝 10 送路基板30のゆがみ、鞍鎖を防ぐ。

【①①34】また図には示していないが、伝送路墓板3 0の核検査デバイス10と反対側は外部の電源供給装置 と締続するためのコネクタを支持プロック50に設ける ことができ、そのコネクタに伝送路31からそれぞれ配 線を引き出すことで電源供給装置との接続が可能とな る.

【①①35】次に本発明の他の実施の形態を図3乃至図 8を参照して説明する。尚、図3万至図8において図1 および図2と同一もしくは類似の箇所は同じ符号を付し 20 てあり、また。図1および図2から理解が容易な箇所は 図面が頻維となるのを避けるために符号を省略してい

【0036】図3は、本発明による多ピン電源供給プロ ープの第2の実施の形態による構成を説明する上面図で ある。

【0037】図3において、彼検査デバイス10側の配 線シート20aの先端部分の形状は、電源配線21とグ ランド配線22が存在する部分のみが突出していて、そ の突出している電源配線21とグランド配線22の上側 30 には、絶縁体24と第1のベタグランド面23が配置し てある。配線シート20aの先端部分を突出することに より、それぞれの配線が独立に挽むことができる。彼検 査デバイス10の電極高さにばらつきがある場合でも、 配線が独立に撓むことでその電極高さばらつきを吸収し て良好な接触が可能となる。

【① ① 3 8 】図4は、本発明による多ピン電源供給プロ ープの第3の実施の形態による構成を説明する側面図で

[0039] 図4において、電源配線21とグランド配 40 成分を低減できる。 線22の被検査デバイス10の電極と接触する先端部分 には、金属突起60が設けてある。これにより、電極と の接触面積が小さくなり低い接触圧力で安定した接触が でき、かつ低い接触圧力で接触できるため機械的寿命を 長くすることができる。

【① ① 4 ① 】 図5 および図6は、本発明による多ピン電 源供給プローブの第4 および第5 のの実施の形態による 構成をそれぞれ説明する下面図である。

【①①41】図示していない彼検査デバイスの隣接した 電源電極が同一種類の電源電圧の場合に適用するもので 50 被検査デバイスのグランド電極に接触するグランド配線

あり、図5では、同一種類の電源電極に接触する電源配 線21と接続する単板コンデンサ40aは、電源電圧が 共通なため一つの単板コンデンサ40aで構成できる。 これにより、使用する単板コンデンサの数を少なくで き、部品点数削減に効果がある。

【10042】図6では、接検査デバイスの電源電極に接 触する先繼部分を除き互いの電源配線の間にある隙間を 金属配線で埋めた電源配線21aで形成している。これ により、廻めた金属配線の面積分だけ容置成分が増し、 さらに大きい容量を付加できる。

【()()43】図?は、本発明の第6の実施の形態の多ピ ン電源供給プローブにおいて、単板コンデンサの部分を 拡大した下面図である。

【①①44】図?において、電源配線21と単板コンデ ンサ40と伝送路31の接続を金属ワイヤ41にかえて 金属ワイヤ4)よりも断面積が大きい金属リボン42で 接続している。これにより、電源配線21と単板コンデ ンサ40と伝送路31の接続部分のインダクタンス成分 を低減することができる。

【()()45]図8は、本発明の第7の実施の形態による 多ビン電源供給プローブの構成を説明する側面図であ

【0046】図8において、彼検査デバイス10 aには 電源電極11aがありその反対面にグランド電極12a が配置してある。配線シート20万には、電源配線21 のみが配置してありグランド配線は存在しない。核検査 デバイス10aは金属ステージ71の上に配置してあ り、グランド電極12 aはこの金属ステージ71と電気 的に導通している。伝送路墓板のグランドライン32に は金属でできたグランドブロック70が接続してある。 グランドブロック70は、グランドライン32から彼検 査デバイス10aの方向に伸びた配線シート20bと平 行な面を持ち、その先繼部分で金属ステージ?」と接触 している。グランドブロック70と配線シート20bの 第1のベタグランド面は電気的に接続しており、これに より被検査デバイス10aのグランド電極12aと第1 のベタグランド面は同電位となる。グランド電板12 a と同電位となる第1のベタグランド面が電源配線の上側 にあることより、電源配線の先端部分のインダクタンス

【①①47】配線シート20かと伝送路31の間にある グランドライン32には、単板コンデンサ40が接続し てあり、より大きな容置を付加することができる。電源 配線と伝送路31は、単板コンデンサ40に金属ワイヤ 41で電気的に接続してある。伝送路基板の上側には支 **待ブロック50が配置してある。**

[0048]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、 被検査デバイスの電源電極に接触する電源配線の上側に

特關2003-152036

と電気的に接続する第1のベタグランド面を絶縁体を介して配置することにより、被検査デバイスの複数の電源 電極に対して個々に隣接したグランド電極を配置しなく とも電源配線の先端部分のインダクタンス成分を低減で きる。これにより、グランド電極の数を削減でき、彼検 査デバイスの面積を小さくできる。

【① ① 4 9 】また、電源配線とグランド配線の間にコンデンサ部品を挿入しなくとも容置成分が付加できるので、配線間のビッチを小さくでき狭ビッチ(例えば2 ① 0 μ m以下)の電極配置を持つ彼検査デバイスへの電源供給が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す図であり、図

1 (a)は下面図、図1 (b)は側面図である

【図2】本発明の第1の実施の形態を示す図であり、図

2 (a) は図1 (a) のA - A部の断面図であり、図2(b) は図1 (a) のB - B部の断面図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態の上面図である

【図4】本発明の第3の実施の形態において、被検査デ

バイスと接触している状態を示す側面図である

【図5】本発明の第4の実施の形態の下面図である

【図6】本発明の第5の実施の形態の下面図である

【図?】本発明の第6の実施の形態において、単板コン デンサの箇所を拡大した下面図である。 *【図8】本発明の第7の実施の形態の側面図である 【図9】従来技術のプローブを示した図である 【符号の説明】

10.10a 彼検査デバイス

11.11a 電源電板

12.12 a グランド電極

20.20a.20b 配線シート

21.21a 電源配線

22 グランド配線

0 23 第1のベタグランド面

24 絶縁体

(5)

25 スルーホール

3 () 伝送路基板

31 伝送路

32 グランドライン

33 第2のベタグランド面

34 絶縁体

4.(), 4.() a 単板コンデンサ

4.1 金属ワイヤ

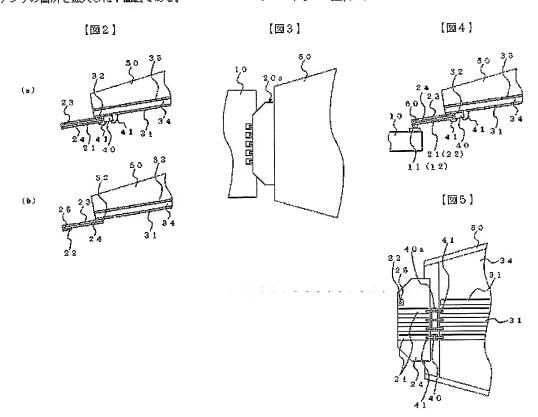
20 4.2 金属リボン

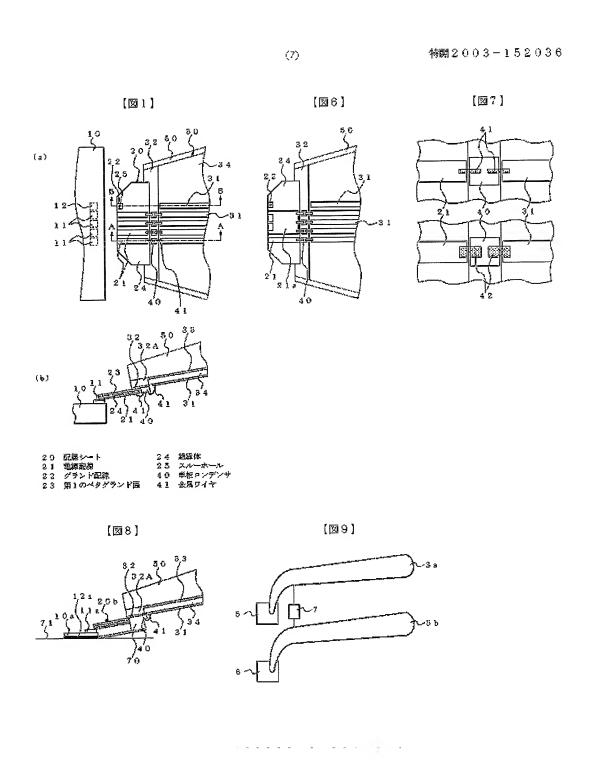
50 支持ブロック

6 () 金属突起

70 グランドブロック

* 71 金属ステージ





特闘2003-152036

(8)

フロントページの続き

Fターム(参考) 20003 AE03 AG03 AG08 AG12 AH05 AH09 20011 AA03 AA15 AA21 AB06 AB08 AB09 AC14 AC32 AC33 AE01 AF07 2G132 AA00 AF02 AL00 AL03 AL18 AL19

4N106 AA01 AA02 BA01 DD03